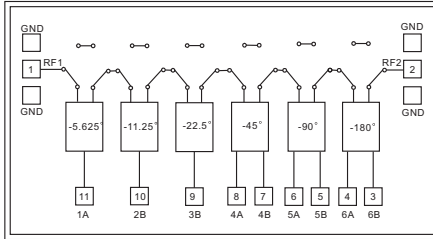


性能特点

- 工作频段：1.2~1.4GHz
- 插入损耗：4dB
- 移相精度（RMS）：0.5°
- 幅度波动：±0.5dB
- 芯片尺寸：2.5x3.3x0.1mm

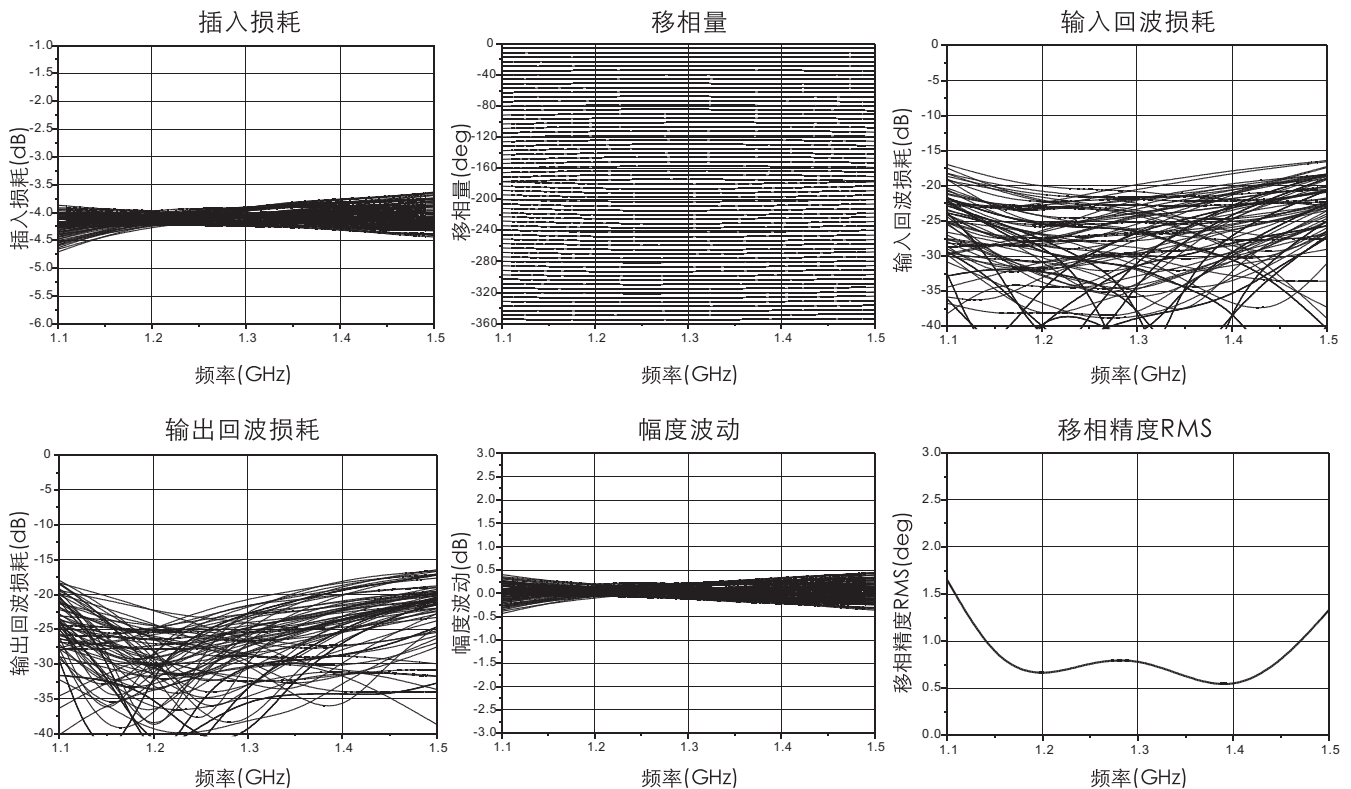
功能框图



电性能表(TA =+25℃, 0/-5V控制, 50Ωsystem)

参数	频率	最小值	典型值	最大值	单位
插入损耗	1.2~1.4GHz	-	4	-	dB
幅度波动	1.2~1.4GHz	-	±0.5	-	dB
回波损耗(RF1、RF2)	1.2~1.4GHz	-	20	-	dB
移相精度(RMS)	1.2~1.4GHz	-	0.5	-	deg
输入P-1	1.2~1.4GHz	-	21	-	dBm
输入IP3	1.2~1.4GHz	-	35	-	dBm
开关时间	-	-	10	-	ns

测试曲线（射频端口使用一根300um键合线）



BW1255型GaAs单片集成6位数控移相器

极限参数

射频输入功率 (VcII=-5V)	+24dBm
控制电压范围 (CtrlA、CtrlB)	+0.5V ~ -7V
结温	175℃
储存温度	-65 ~ +150℃
工作温度	-55 ~ +125℃
静电防护等级(HBM)	Class1A

控制电压

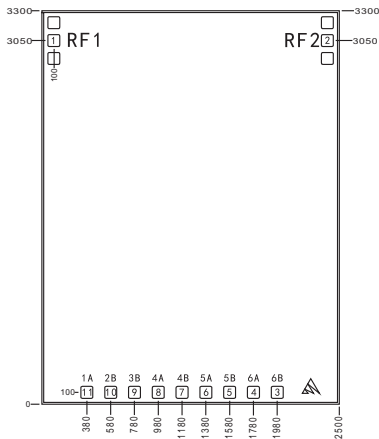
状态	偏置条件
低 (0)	0~-0.2V
高 (1)	-3~-5V



真值表

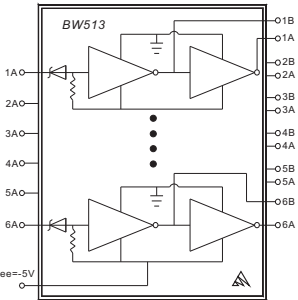
-5.625°	-11.25°	-22.5°	-45°		-90°		-180°		移相 状态
1A	2B	3B	4A	4B	5A	5B	6A	6B	
1	0	0	1	0	1	0	1	0	参考态
0	0	0	1	0	1	0	1	0	-5.625°
1	1	0	1	0	1	0	1	0	-11.25°
1	0	1	1	0	1	0	1	0	-22.5°
1	0	0	0	1	1	0	1	0	-45°
1	0	0	1	0	0	1	1	0	-90°
1	0	0	1	0	1	0	0	1	-180°

外形尺寸



- 说明:
- 1.单位: 微米
 - 2.芯片背面镀金
 - 3.芯片背面接地
 - 4.键合压点镀金,压点尺寸: 1, 2: 100um×100um
 - 5.不能在通孔上进行键合
 - 6.外形尺寸公差: ±50μm

推荐驱动电路形式



备注: BW513是单片集成6位FET驱动器

键合压点定义

压点编号	功能符号	功能描述
1, 2	RF1, RF2	RF端口, 阻抗50ohm, 射频通路不是0V, 需外接隔直电容
3, 5, 7, 9, 11, 13	CtrlA	控制端口
4, 6, 8, 10, 12, 14	CtrlB	控制端口
-	GND	芯片背面必须接地

应用信息

装配图 (射频端口建议使用一根300um键合线)

